

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年5月21日(2009.5.21)

【公開番号】特開2008-124111(P2008-124111A)

【公開日】平成20年5月29日(2008.5.29)

【年通号数】公開・登録公報2008-021

【出願番号】特願2006-303676(P2006-303676)

【国際特許分類】

H 01 L 21/205 (2006.01)

C 23 C 16/505 (2006.01)

C 23 C 16/52 (2006.01)

C 23 C 16/24 (2006.01)

H 01 L 31/04 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/205

C 23 C 16/505

C 23 C 16/52

C 23 C 16/24

H 01 L 31/04 X

【手続補正書】

【提出日】平成21年4月6日(2009.4.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0081

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0081】

また、形成されたシリコン薄膜の結晶化度(Ic/Ia)の測定結果と成膜時のプラズマポテンシャルとの関係を図5に示す。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0101

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0101】

1 成膜室

11 成膜室1の天井壁

111 天井壁11に設けた電気絶縁性部材

2 基板ホルダ

21 ヒータ

3 誘導結合型アンテナ

31、32 アンテナ3の端部

4 高周波電源

41 マッチングボックス

5 排気ポンプ

51 コンダクタンスバルブ

6 成膜原料ガス供給部

7 希釈ガス供給部

8 終端処理用ガス供給部
1 0 プラズマ診断装置
1 0 a ラングミュアプローブ
1 0 b プラズマ診断部
1 0 0 圧力計